
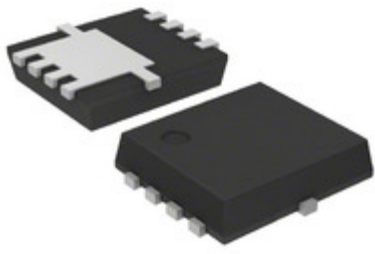
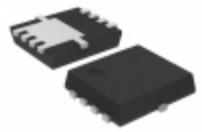
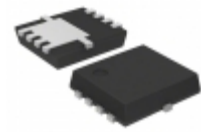



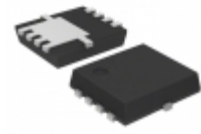

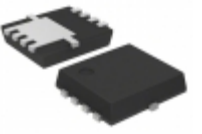
	<h2>RQ3E180GNTB</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RQ3E180GNTB</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 18A 8-HSMT</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RQ3E180GNTB.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	RQ3E180GNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 18A 8-HSMT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.3 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1520pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta)

RQ3E180GNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3E180GNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3E180GNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3E180GNTB E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RQ3G100GNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 40V 10A TSMT</p>	 <p><b>RQ3E180AJTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A HSMR8</p>	 <p><b>RQ3E160ADTB1</b> ROHM/ RQ3E160ADTB1 ROHM/</p>	 <p><b>RQ3E180GN</b> QQ2850920316 RQ3E180GN QQ2850920316</p>
 <p><b>RQ3G100GN</b> ROHM RQ3G100GN ROHM</p>	 <p><b>RQ3E180BNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8HSMT</p>	 <p><b>RQ3E180BN</b> QQ2850920316 RQ3E180BN QQ2850920316</p>	 <p><b>RQ3L050GNTB</b> Rohm Semiconductor NCH 60V 12A MIDDLE POWER MOSFET</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RQ3E180GNTB LAPIS Semiconductor	RQ3E180GNTB Datenblatt	RQ3E180GNTB-Datenblätter	RQ3E180GNTB PDF	LAPIS Semiconductor RQ3E180GNTB
RQ3E180GNTB Electronic	RQ3E180GNTB-Komponenten	RQ3E180GNTB-Verteiler	RQ3E180GNTB-Bild	RQ3E180GNTB-Teil
RQ3E180GNTB Preis	RQ3E180GNTB Hersteller	RQ3E180GNTB Bild	RQ3E180GNTB Aktie	RQ3E180GNTB Inventar
RQ3E180GNTB Neu	RQ3E180GNTB Original	RQ3E180GNTB garantiert	RQ3E180GNTB RFQ	RQ3E180GNTB Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited